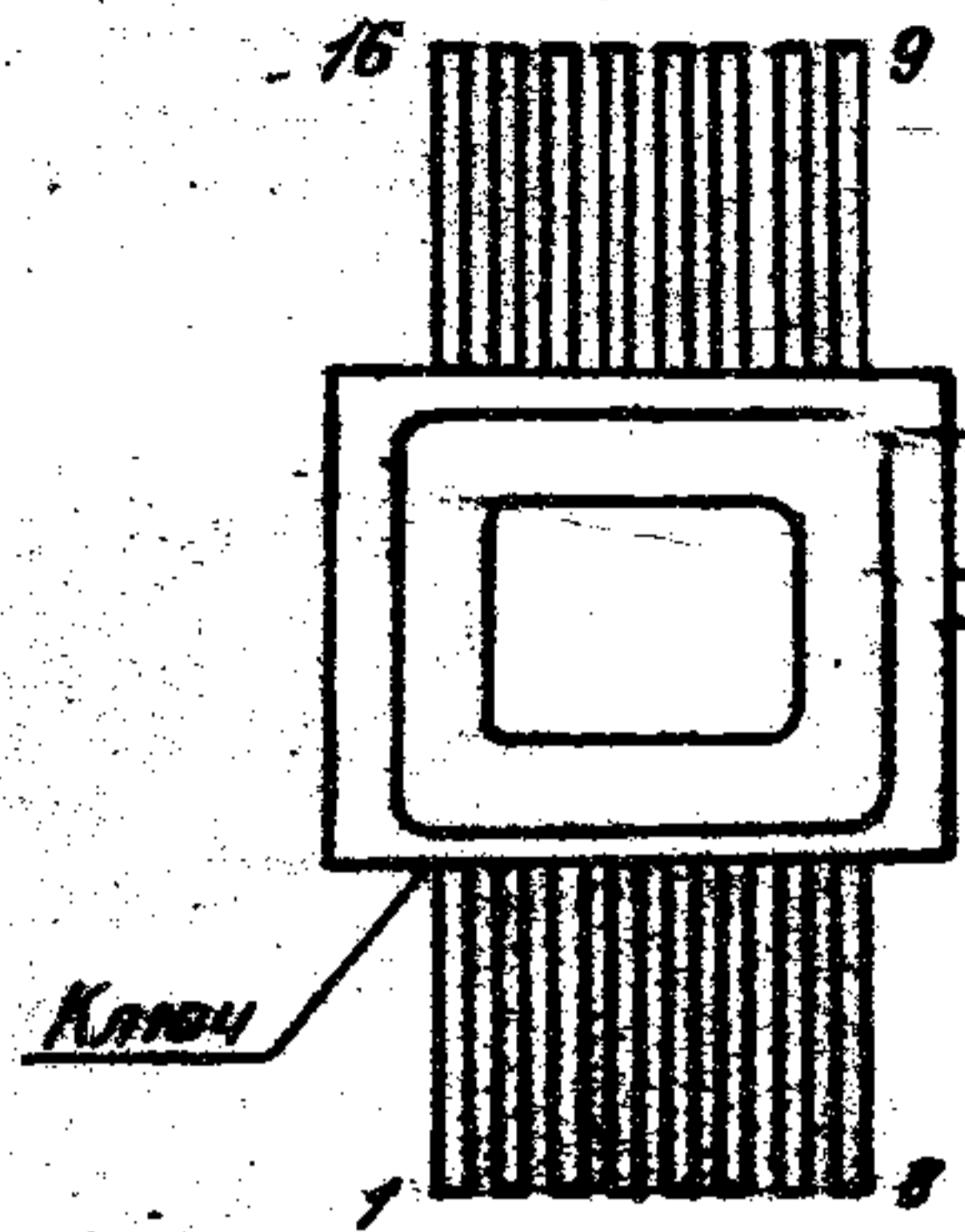




Э Т И К Е Т К А

Полупроводниковая интегральная микросхема 505ИР2 представляет собой 1024-разрядный динамический последовательный регистр сдвига, состоящий из 4-х регистров с числом разрядов 256 каждый с отдельными входами и выходами и общими цепями сдвига и питания. Климатическое исполнение УХЛ и В.



Масса не более 2 г

ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

Обозначение вывода	Наименование вывода	Обозначение вывода	Наименование вывода	Обозначение вывода	Наименование вывода	Обозначение вывода	Наименование вывода
1	Вых.1	5	$U_{ф2}$	9	$U_{ф2}$	13	Вх.4
2	Вх.1	6	Вх.2	10	Вых.3	14	Вх.4
3	Вх.1	7	Вх.2	11	Вх.3	15	Вых.4
4	$U_{ф1}$	8	Вых.2	12	Вх.3	16	$U_{ф1}$

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ  $t = 25^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а		Примечание
		не менее	не более	
1. Ток на вспомогательном входе, мА	$I_{вх}$	0,4	2,0	1
2. Ток утечки на входе, мкА	$I_{ут.вх}$	-	1,0	2
3. Ток утечки на входе тактового импульса $\Phi 1$ и $\Phi 2$ , мкА	$I_{ут.ф}$	-	2,0	3
4. Ток потребления, мА	$I_{пот.}$	-	70	4,5
5. Выходной ток логического нуля, мА	$I'_{вых}$	1,6	6,0	2,5
6. Выходное напряжение логической единицы, В	$U'_{вых}$	$U_{нл2} - 1,2$	-	5,6
7. Время считывания логической единицы, нс	$t_{сч.е}$	-	190	5,6
8. Время считывания логического нуля, нс	$t_{сч.н}$	-	190	5,6
9. Задержка выходного сигнала относительно входного на высокой частоте, бит	$R_{вы}$	256		5,6
10. Задержка выходного сигнала относительно входного на низкой частоте, бит	$R_{нв}$			6,7

- Примечания:
1. При  $U_{нл1} =$  минус 4,75 В;  $U_{нл2} = 4,75$  В.
  2. При  $U_{нл1} =$  минус 5,25 В;  $U_{нл2} = 5,25$  В;  $U'_{вх} =$  минус 10,5 В;  $U'_{ф} =$  минус 1,6 В (величины  $U'_{вх}$  и  $U'_{ф}$  устанавливаются относительно  $U_{нл2}$ ).
  3. При  $U_{нл1} = U_{нл2} = 5,25$  В;  $U'_{вх} =$  минус 10,5 В;  $U'_{ф} =$  минус 17,85 В (величины  $U'_{вх}$  и  $U'_{ф}$  устанавливаются относительно  $U_{нл2}$ ).
  4. При  $U_{нл1} =$  минус 5,25 В;  $U_{нл2} = 5,25$  В;  $U'_{вх} =$  минус 1,6 В;  $U'_{вх} =$  минус 4,45 В;  $U'_{ф} =$  минус 17,85 В;  $U'_{ф} =$  минус 1,6 В (величины  $U'_{вх}$ ,  $U'_{вх}$ ,  $U'_{ф}$ ,  $U'_{ф}$  устанавливаются относительно  $U_{нл2}$ ).
  5. При  $T_{ф} = 1$  мкс;  $t_{уф} = 0,2$  мкс;  $t_{здт} \geq 0,2$  мкс;  $t_{ф}, t_{с} \leq 50$  нс.
  6. При  $U_{нл1} =$  минус 4,75 В;  $U_{нл2} = 4,75$  В;  $U'_{вх} =$  минус 1,6 В;  $U'_{вх} =$  минус 3,95 В;  $U'_{ф} =$  минус 16,15 В;  $U'_{ф} =$  минус 1,6 В (величины  $U'_{вх}$ ,  $U'_{вх}$ ,  $U'_{ф}$ ,  $U'_{ф}$  устанавливаются относительно  $U_{нл2}$ ).
  7. При  $T_{ф} = 100$  мкс;  $t_{уф} = 1,0$  мкс;  $t_{здт} \geq 48$  мкс;  $t_{ф}, t_{с} \leq 500$  нс.

Содержание драгоценных металлов в одном изделии:

Золото 19-4841 Серебро 30-56

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ

Микросхемы 505MP2 соответствуют техническим условиям ОК0.347.041 ТУ.

Приняты по извещению № 519 от 04.89  
дата

Приняты по извещению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
дата

ВТК 203

16